

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成18年1月19日(2006.1.19)

【公開番号】特開2002-278053(P2002-278053A)

【公開日】平成14年9月27日(2002.9.27)

【出願番号】特願2001-76747(P2001-76747)

【国際特許分類】

G 03 F	7/004	(2006.01)
C 08 K	5/41	(2006.01)
C 08 L	101/00	(2006.01)
G 03 F	7/039	(2006.01)
H 01 L	21/027	(2006.01)

【F I】

G 03 F	7/004	5 0 3 A
C 08 K	5/41	
C 08 L	101/00	
G 03 F	7/039	6 0 1
H 01 L	21/30	5 0 2 R

【手続補正書】

【提出日】平成17年11月29日(2005.11.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

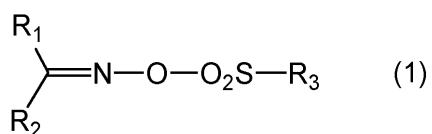
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】(a)酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂、

(b)下記一般式(1)で表される活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物と、下記一般式(2)で表される活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有することを特徴とするポジ型フォトレジスト組成物。

【化1】

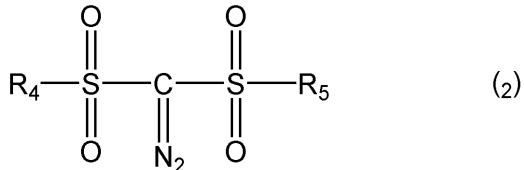


一般式(1)中、R₁、R₂は、炭素数1から16の置換基を有していても良いアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、シクロアルキル基、シクロアルケニル基、置換基を有していても良いアリール基、ヘテロアリール基、シアノ基、を表す。

また、R₁とR₂は、炭素数2から8の置換基を有していても良いアルキレン鎖、アルケニレン鎖、アルキニリン鎖、または、置換基を有していても良いフェニレン、フリーレン、チエニレン、-O-、-S-、-N-、-CO-を含む連結鎖を介して、別の一般式(1)で表される化合物のR₁またはR₂と結合されていても良い。

R₃は炭素数1～16個の置換基を有していても良いアルキル基、シクロアルキル基、置換基を有していても良いアリール基を表す。

【化2】



一般式(2)中、R₄、R₅は、置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基を表す。

【請求項2】 請求項1に記載のポジ型フォトレジスト組成物によりレジスト膜を形成し、当該レジスト膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。